

КУЗНЕЦОВ ГЕННАДИЙ ДМИТРИЕВИЧ (к 75-летию со дня рождения)

21 апреля 2015 г. исполнилось 75 лет со дня рождения и более 50 лет практической, научной и педагогической деятельности широко известного специалиста в области физики и технологии тонких пленок, профессора, доктора технических наук, академика РАЕН Геннадия Дмитриевича Кузнецова.

Геннадий Дмитриевич Кузнецов в 1963 г. окончил с красным дипломом Московский институт стали и сплавов (МИСиС). С 1963 по 1970 г. он работал на предприятиях среднего машиностроения СССР. В 1967 г. Г. Д. Кузнецов защитил кандидатскую диссертацию в области разработки новых ионно-плазменных процессов формирования высокотемпературных покрытий со специальными свойствами.

В 1970 г. Геннадий Дмитриевич перешел на работу в МИСиС на факультет полупроводниковых материалов и приборов на кафедру «Физическая химия и технология полупроводниковых материалов и особо чистых металлов», которой руководили профессор А. Н. Крестовников, а затем профессор В. В. Крапунин.

В МИСиС Г. Д. Кузнецов энергично взялся за организацию научного и учебно-методического направления подготовки специалистов в области исследования и использования эффектов, возникающих в твердом теле и тонкопленочных гетерокомпозициях при низкоэнергетическом ионном и электронном взаимодействиях, а также при плазмохимических процессах формирования гетероструктур. В учебно-методической работе значительное внимание Г. Д. Кузнецов уделил атомно-молекулярным процессам получения микро- и наноразмерных гетероструктур. Под его руководством была создана научная и специализированная лаборатория по вакуум-плазменным процессам в технологии микро- и nanoиндустрии.

В 1983 г. Г. Д. Кузнецов защитил докторскую диссертацию по ионно-плазменным процессам получения гетероструктур для устройств преобразования энергии и информации; в 1986 г. ему присвоено звание профессора. Все годы работы в МИСиС Г. Д. Кузнецов уделял внимание подбору и созданию профессиональной работоспособной группы по возглавляемой им научной и учебно-методической тематике.



В 1986 г. Геннадий Дмитриевич избран деканом факультета полупроводниковых материалов и приборов. За время работы в деканате, являясь членом секции по материаловедению и технологии полупроводниковых материалов учебно-методического объединения вузов России, он укрепил авторитет факультета в области учебно-методической работы по подготовке специалистов-материаловедов и технологов, проведя первое заседание в секции в МИСиС с представителями более чем 30 вузов страны. По инициативе и при непосредственном участии профессора Г. Д. Кузнецова в МИСиС с 1994 г. открыта подготовка специалистов по многоуровневой системе с созданием новых учебных планов и программ для

бакалавров и магистров по специализации «Процессы микро- и нанотехнологий».

С 1990 по 1998 г. Г. Д. Кузнецов успешно возглавлял созданную на факультете полупроводниковых материалов и приборов кафедру «Микротехнология компонентов электронной техники», основной задачей которой была подготовка бакалавров, магистров и инженеров по физике и технологии тонких пленок полупроводников, металлов и диэлектриков для микроэлектроники. За эти же годы было выпущено более 150 специалистов.

За время работы в университете Г. Д. Кузнецовым создана научно-педагогическая школа в области физики и эллионной технологии тонкопленочных устройств преобразования энергии. В рамках созданного научного направления под руководством профессора Г. Д. Кузнецова подготовлено 3 доктора и 16 кандидатов наук, 26 магистров, включая магистров из Союза Мьянма, более 40 бакалавров, свыше 80 инженеров. Опубликовано более 300 научных работ, в соавторстве изданы 3 монографии и учебник по технологии материалов электронной техники, 18 учебно-методических пособий.

Научная деятельность Геннадия Дмитриевича в настоящее время направлена на теоретическое и экспериментальное обоснование возможности использования ионных процессов для создания микро- и наноразмерных гетероструктур и устройств на основе твердых растворов карбида кремния для экстремальной электроники.

Г. Д. Кузнецов является членом двух специализированных ученых советов по защите кандидатских

и докторских диссертаций, членом секции РАН по прямому преобразованию энергии, членом секции по нанотехнологии и микросистемной технике научно-методического совета по автоматике и электронике, членом редколлегии журнала «Известия вузов. Материалы электронной техники», ведущим экспертом Центра энергоэффективности НИТУ «МИСиС».

За значительный вклад в развитие науки и методического обеспечения подготовки специалистов Г. Д. Кузнецов неоднократно отмечен грамотами и знаками Министерства образования и науки Российской Федерации; является почетным работником высшего профессионального образования России.

Руководство НИТУ «МИСиС», ИНМиН и редколлегия журнала «Известия высших учебных заведений. Материалы электронной техники» поздравляют профессора Геннадия Дмитриевича Кузнецова с юбилеем и желают ему здоровья и дальнейших творческих успехов

К 80-летию СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ЛЕОНИДА МИХАЙЛОВИЧА ЛЕТЮКА (1935–2007 гг.)

3 мая 2015 г. видному ученому, крупному специалисту в области материаловедения и технологии ферритовых материалов, доктору технических наук, профессору Леониду Михайловичу Летюку исполнилось бы 80 лет.

Леонид Михайлович родился 3 мая 1935 г. В 1963 г. окончил физико-химический факультет Московского института стали и сплавов (МИСиС).

По окончании МИСиС Леонид Михайлович с 1961 по 1964 г. работал инженером, а затем старшим инженером во ВНИИ твердых сплавов (г. Москва). В 1964 г. Л. М. Летюк поступает в МИСиС в аспирантуру к профессору Б. Е. Левину. В то время в МИСиС как раз начал формироваться коллектив специалистов, чьи научные интересы были прикованы



к активно развивающемуся классу новых магнитных материалов — ферритам. Именно этим коллективом позже была создана единственная в вузах СССР учебная специализация по подготовке специалистов для ферритовой отрасли. Специализация была не только единственной, но и уникальной, так как позволяла будущим инженерам получить комплекс знаний по основам магнетизма твердых тел, технологии и материаловедению ферритов, а также устройству и принципам работы приборов на базе этих материалов.

В 1967 г. Л. М. Летюк защитил кандидатскую диссертацию, а в 1977 г. — докторскую. В 1980 г. ему было присвоено ученое звание профессора.

С 1980 по 1982 г. Леонид Михайлович возглавлял физико-химический факультет МИСиС, а с 1982 по 1987 г. — факультет полупроводниковых материалов и приборов. В 1984 г. проф. Л. М. Летюк был избран заведующим кафедрой физической химии и технологии полупроводниковых материалов и особо чистых металлов (ныне кафедра технологии материалов

электроники), которой он заведовал по 1998 г.

В 1987 г. проф. Л. М. Летюку была присуждена Государственная премия за работу «Разработка принципов легирования магнитотвердых ферритов, создание на их основе новых высокоэнергетических бескобальтовых оксидных магнитов, организация их массового автоматизированного производства и внедрение в народное хозяйство», а в 1995 г. присвоено почетное звание «Заслуженный деятель науки и техники Российской Федерации». В 1997 г. Л. М. Летюк был избран действительным членом Академии минерального сырья и ресурсов.

Леонид Михайлович по праву считается одним из создателей в СССР научной школы в

области материаловедения и технологии оксидных магнетиков — ферритов. Возглавляемое этой школой научное направление связано с исследованием механизмов формирования кристаллической структуры и микроструктуры ферритов различных структурных классов, изучением характера влияния на проявление этих механизмов изоморфных замещений, легирования, предыстории исходных компонентов, различного рода физических и технологических воздействий с последующим установлением коррелятивных связей «реальная кристаллическая структура и микроструктура — свойства — технология» и определением основных путей использования этих связей в управлении технологией производства оксидных изделий магнитоэлектроники.

Значительный вклад Л. М. Летюк внес в разработку ресурсосберегающих и малоотходных технологий (переработка отходов ферритового производства, утилизация оксида железа из отработанных травильных растворов металлургических производств путем